Symbol	Typ	Titel
C	**Sektion**	**Sektion C — Chemie; Hüttenwesen**
C30	**Klasse**	**Züchten von Kristallen [3]**
C30B	**Unterklasse**	**Züchten von Einkristallen (durch Anwendung von Ultra-Hochdruck, z.B. zur Erzeugung von Diamanten, B01J 3/06); Gerichtetes Erstarren von eutektischen Stoffen oder gerichtetes Entmischen von eutektischen Stoffen; Reinigen von Stoffen durch Zonenschmelzen (Reinigen von Metallen oder Legierungen durch Zonenschmelzen C22B); Herstellung eines homogenen polykristallinen Stoffes mit definierter Struktur (Gießen von Metallen, Gießen anderer Werkstoffe nach dem gleichen Verfahren oder mit den gleichen Vorrichtungen B22D; Verarbeiten von Kunststoffen B29; Veränderung der physikalischen Struktur von Metallen oder Legierungen C21D , C22F); Einkristalle oder homogene polykristalline Stoffe mit definierter Struktur; Nachbehandlung von Einkristallen oder eines homogenen polykristallinen Stoffes mit definierter Struktur (zur Herstellung von Halbleiterbauelementen oder ihren Teilen H10); Apparate hierfür [3]**
		Einkristallwachstum aus festen Stoffen oder Gelen [3]
C30B 1/00	**Hauptgruppe**	**Einkristallwachstum direkt aus dem festen Zustand (gerichtetes Entmischen von eutektischen Stoffen C30B 3/00; unter einem schützenden Fluid C30B 27/00) [3, 2006.01]**
C30B 1/02	1-Punkt Untergruppe	. durch Wärmebehandlung, z.B. Ausglühen von Gitterspannungen (C30B 1/12 hat Vorrang) [3, 2006.01]
C30B 1/04	2-Punkt Untergruppe	. . Isotherme Rekristallisation [3, 2006.01]
C30B 1/06	2-Punkt Untergruppe	. . Rekristallisation unter einem Temperaturgradienten [3, 2006.01]
C30B 1/08	3-Punkt Untergruppe	. . . Zonenrekristallisation [3, 2006.01]
C30B 1/10	1-Punkt Untergruppe	. durch Feststoffreaktion oder Mehrphasen-Diffusion [3, 2006.01]
C30B 1/12	1-Punkt Untergruppe	. durch Druckbehandlung während des Wachstums [3, 2006.01]
C30B 3/00	**Hauptgruppe**	**Gerichtetes Entmischen von eutektischen Stoffen [3, 2006.01]**
C30B 5/00	**Hauptgruppe**	**Einkristallwachstum aus Gelen (unter einem schützenden Fluid C30B 27/00) [3, 2006.01]**
C30B 5/02	1-Punkt Untergruppe	. unter Zugabe von Dotierstoffen [3, 2006.01]
		Einkristallwachstum aus Flüssigkeiten; gerichtetes Erstarren von eutektischen Stoffen [3]
C30B 7/00	**Hauptgruppe**	**Einkristallwachstum aus Lösungen unter Verwendung von Lösungsmitteln, die bei normaler Temperatur flüssig sind, z.B. wässrige Lösungen (aus geschmolzenen Lösungsmitteln C30B 9/00; durch Kühlen mit oder ohne Temperaturgradient C30B 11/00; unter einem schützenden Fluid C30B 27/00) [3, 2006.01]**
C30B 7/02	1-Punkt Untergruppe	. durch Verdampfung des Lösungsmittels [3, 2006.01]
C30B 7/04	2-Punkt Untergruppe	. . unter Verwendung von wässrigen Lösungsmitteln [3, 2006.01]
C30B 7/06	2-Punkt Untergruppe	. . unter Verwendung von nichtwässrigen Lösungsmitteln [3, 2006.01]
C30B 7/08	1-Punkt Untergruppe	. durch Abkühlen der Lösung [3, 2006.01]
C30B 7/10	1-Punkt Untergruppe	. durch Anwendung von Druck, z.B. hydrothermale Verfahren [3, 2006.01]
C30B 7/12	1-Punkt Untergruppe	. durch Elektrolyse [3, 2006.01]
C30B 7/14	1-Punkt Untergruppe	. die auskristallisierenden Stoffe werden durch chemische Reaktionen in der Lösung gebildet [3, 2006.01]
C30B 9/00	**Hauptgruppe**	**Einkristallwachstum aus Lösungsschmelzen unter Verwendung von geschmolzenen Lösungsmitteln (durch Kühlen mit oder ohne Temperaturgradient C30B 11/00; durch Zonenschmelzen C30B 13/00; Kristallziehen C30B 15/00; auf einem eingetauchten Keimkristall C30B 17/00; durch Flüssigphasen-Epitaxie C30B 19/00; unter einem schützenden Fluid C30B 27/00) [3, 2006.01]**

Symbol	Typ	Titel
C30B 9/02	1-Punkt Untergruppe	. durch Verdampfen des geschmolzenen Lösungsmittels [3, 2006.01]
C30B 9/04	1-Punkt Untergruppe	. durch Kühlen der Lösung [3, 2006.01]
C30B 9/06	2-Punkt Untergruppe	. . unter Verwendung von einer Komponente der Kristallverbindung als Lösungsmittel [3, 2006.01]
C30B 9/08	2-Punkt Untergruppe	. . unter Verwendung von anderen Lösungsmitteln [3, 2006.01]
C30B 9/10	3-Punkt Untergruppe	. . . metallische Lösungsmittel [3, 2006.01]
C30B 9/12	3-Punkt Untergruppe	. . . Salze als Lösungsmittel, z.B. Wachstum aus Schmelzen mit Flussmitteln [3, 2006.01]
C30B 9/14	1-Punkt Untergruppe	. durch Elektrolyse [3, 2006.01]
C30B 11/00	**Hauptgruppe**	**Erzeugen von Einkristallen durch Kühlen mit oder ohne Temperaturgradient, z.B. Bridgman-Stockbarger-Methode (C30B 13/00 , C30B 15/00 , C30B 17/00 , C30B 19/00 haben Vorrang; unter einem schützenden Fluid C30B 27/00) [3, 2006.01]**
C30B 11/02	1-Punkt Untergruppe	. ohne Lösungsmittel (C30B 11/06 hat Vorrang) [3, 2006.01]
C30B 11/04	1-Punkt Untergruppe	. Einbringen der zu kristallisierenden Stoffe oder der den Stoff in situ bildenden Komponenten in die Schmelze [3, 2006.01]
C30B 11/06	2-Punkt Untergruppe	. . wobei wenigstens eine, aber nicht alle Komponenten der Kristallverbindung zugegeben werden [3, 2006.01]
C30B 11/08	2-Punkt Untergruppe	. . wobei alle Komponenten der Kristallverbindung während der Kristallisation zugegeben werden [3, 2006.01]
C30B 11/10	3-Punkt Untergruppe	. . . feste oder flüssige Komponenten, z.B. Verneuil-Methode [3, 2006.01]
C30B 11/12	3-Punkt Untergruppe	. . . dampfförmige Komponenten, z.B. VLS- [vapour-liquid-solid] Verfahren [3, 2006.01]
C30B 11/14	1-Punkt Untergruppe	. gekennzeichnet durch den Keimkristall, z.B. seine kristallografische Orientierung [3, 2006.01]
C30B 13/00	**Hauptgruppe**	**Erzeugen von Einkristallen durch Zonenschmelzen; Reinigen durch Zonenschmelzen (C30B 17/00 hat Vorrang; durch Ändern des Querschnitts des behandelten festen Stoffes C30B 15/00; unter einem schützenden Fluid C30B 27/00; für das Wachstum von homogenen polykristallinen Stoffen mit definierter Struktur C30B 28/00) [3, 5, 2006.01]**
C30B 13/02	1-Punkt Untergruppe	. Zonenschmelzen mit einem Lösungsmittel, z.B. travelling-solvent-Methode [Verwendung einer wandernden Schmelzlösungsmittelzone] [3, 2006.01]
C30B 13/04	1-Punkt Untergruppe	. Homogenisieren durch "zone-levelling" [3, 2006.01]
C30B 13/06	1-Punkt Untergruppe	. die Schmelzzone nimmt nicht den ganzen Querschnitt ein [3, 2006.01]
C30B 13/08	1-Punkt Untergruppe	. Einbringen der zu kristallisierenden Stoffe oder der den Stoff in situ bildenden Komponenten in die Schmelzzone [3, 2006.01]
C30B 13/10	2-Punkt Untergruppe	. . unter Zusetzen von Dotierstoffen [3, 2006.01]
C30B 13/12	3-Punkt Untergruppe	. . . in gasförmigem oder dampfförmigem Zustand [3, 2006.01]
C30B 13/14	1-Punkt Untergruppe	. Tiegel oder Gefäße [3, 2006.01]
C30B 13/16	1-Punkt Untergruppe	. Erhitzen der Schmelzzone [3, 2006.01]
C30B 13/18	2-Punkt Untergruppe	. . wobei das Heizelement in Kontakt mit der Schmelzzone steht oder in sie eingetaucht ist [3, 2006.01]
C30B 13/20	2-Punkt Untergruppe	. . durch Induktion, z.B. Heißdraht-Technik (C30B 13/18 hat Vorrang) [3, 2006.01]
C30B 13/22	2-Punkt Untergruppe	. . durch Bestrahlung oder elektrische Entladung [3, 2006.01]
C30B 13/24	3-Punkt Untergruppe	. . . mit elektromagnetischen Wellen [3, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
C30B 13/26	1-Punkt Untergruppe	. unter Rühren der Schmelzzone [3, 2006.01]
C30B 13/28	1-Punkt Untergruppe	. Steuern oder Regeln [3, 2006.01]
C30B 13/30	2-Punkt Untergruppe	. . Stabilisation oder Formgebung der Schmelzzone, z.B. durch Verdichten, durch elektromagnetische Felder; Steuern des Kristallquerschnitts [3, 2006.01]
C30B 13/32	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen, um entweder die Charge oder das Heizelement zu bewegen [3, 2006.01]
C30B 13/34	1-Punkt Untergruppe	. gekennzeichnet durch den Keim, z.B. durch seine kristallografische Orientierung [3, 2006.01]
C30B 15/00	**Hauptgruppe**	**Erzeugen von Einkristallen durch Ziehen aus einer Schmelze, z.B. Czochralsky-Verfahren (unter einem schützenden Fluid C30B 27/00) [3, 2006.01]**
C30B 15/02	1-Punkt Untergruppe	. Einbringen der zu kristallisierenden Stoffe oder der den Stoff in situ bildenden Komponenten in die Schmelze [3, 2006.01]
C30B 15/04	2-Punkt Untergruppe	. . unter Zusetzen von Dotierstoffen, z.B. für n-p-Übergang [3, 2006.01]
C30B 15/06	1-Punkt Untergruppe	. Nicht-senkrechtes Ziehen [3, 2006.01]
C30B 15/08	1-Punkt Untergruppe	. Abwärtsziehen [3, 2006.01]
C30B 15/10	1-Punkt Untergruppe	. Tiegel oder Behälter für die Schmelze [3, 2006.01]
C30B 15/12	2-Punkt Untergruppe	. . Doppeltiegel-Verfahren [3, 2006.01]
C30B 15/14	1-Punkt Untergruppe	. Erhitzen der Schmelze oder der kristallisierten Stoffe [3, 2006.01]
C30B 15/16	2-Punkt Untergruppe	. . durch Bestrahlung oder elektrische Entladung [3, 2006.01]
C30B 15/18	2-Punkt Untergruppe	. . mit direkter Widerstandsheizung zusätzlich zu anderen Erhitzungsverfahren, z.B. mit Peltier- Wärme [3, 2006.01]
C30B 15/20	1-Punkt Untergruppe	. Steuern oder Regeln (Steuern oder Regeln allgemein G05) [3, 2006.01]
C30B 15/22	2-Punkt Untergruppe	. . Stabilisierung oder Formgebung der Schmelzzone nahe dem gezogenen Kristall; Steuern des Kristallquerschnitts [3, 2006.01]
C30B 15/24	3-Punkt Untergruppe	. . . unter Verwendung von mechanischen Mitteln, z.B. Formwerkzeugen (formgebende Elemente für kantenbestimmtes, schmelzfilmbeschicktes Kristallwachstum C30B 15/34) [3, 2006.01]
C30B 15/26	3-Punkt Untergruppe	. . . unter Verwendung von Fernsehkameras; unter Verwendung von Foto- oder Röntgen-Detektoren [3, 2006.01]
C30B 15/28	3-Punkt Untergruppe	. . . unter Ausnutzung von Gewichtsveränderungen des Kristalls oder der Schmelze, z.B. Flotationsverfahren [Schwimm-Tiegel-Verfahren] [3, 2006.01]
C30B 15/30	1-Punkt Untergruppe	. Vorrichtungen zum Rotieren oder Bewegen der Schmelze oder des Kristalls (Schwimm-Verfahren C30B 15/28) [3, 2006.01]
C30B 15/32	1-Punkt Untergruppe	. Keimhalter, z.B. Spannfutter [3, 2006.01]
C30B 15/34	1-Punkt Untergruppe	. kantenbestimmendes, schmelzfilmbeschicktes Ziehen von Kristallen mit formgebenden Elementen oder Schlitzen [3, 2006.01]
C30B 15/36	1-Punkt Untergruppe	. gekennzeichnet durch den Keim, z.B. durch seine kristallografische Orientierung [3, 2006.01]
C30B 17/00	**Hauptgruppe**	**Einkristallwachstum auf einem Keim, der während des Wachstums in der Schmelze verbleibt, z.B. Nacken-Kyropoulos-Verfahren (C30B 15/00 hat Vorrang) [3, 2006.01]**
C30B 19/00	**Hauptgruppe**	**Flüssigphasen-Epitaxie [LPE-Verfahren] [3, 2006.01]**
C30B 19/02	1-Punkt Untergruppe	. mit geschmolzenen Lösungsmitteln, z.B. Flussmitteln [3, 2006.01]
C30B 19/04	2-Punkt Untergruppe	. . wobei das Lösungsmittel eine Komponente der Kristallverbindung ist [3, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
C30B 19/06	1-Punkt Untergruppe	. Reaktionskammern; Gefäße für die Schmelze; Substratträger [3, 2006.01]
C30B 19/08	1-Punkt Untergruppe	. Erhitzen der Reaktionskammern oder des Substrates [3, 2006.01]
C30B 19/10	1-Punkt Untergruppe	. Steuern oder Regeln (Steuern oder Regeln allgemein G05) [3, 2006.01]
C30B 19/12	1-Punkt Untergruppe	. gekennzeichnet durch das Substrat [3, 2006.01]
C30B 21/00	**Hauptgruppe**	**Gerichtetes Erstarren von eutektischen Stoffen [3, 2006.01]**
C30B 21/02	1-Punkt Untergruppe	. durch einfaches Gießen oder Kühlen mit Temperaturgradient [3, 2006.01]
C30B 21/04	1-Punkt Untergruppe	. durch Zonenschmelzen [3, 2006.01]
C30B 21/06	1-Punkt Untergruppe	. durch Ziehen aus einer Schmelze [3, 2006.01]
		Einkristallwachstum aus der Dampfphase [3]
C30B 23/00	**Hauptgruppe**	**Erzeugen von Einkristallen durch Niederschlagen von verdampften oder sublimierten Stoffen [3, 2006.01]**
C30B 23/02	1-Punkt Untergruppe	. Epitaktisches Schichtenwachstum [3, 2006.01]
C30B 23/04	2-Punkt Untergruppe	. . Abscheiden von Profilen, z.B. durch Maskieren [3, 2006.01]
C30B 23/06	2-Punkt Untergruppe	. . Erhitzen der Abscheidekammer, des Substrats oder der zu verdampfenden Stoffe [3, 2006.01]
C30B 23/08	2-Punkt Untergruppe	. . durch Niederschlagen von ionisierten Dämpfen (durch reaktives Sputtering C30B 25/06) [3, 2006.01]
C30B 25/00	**Hauptgruppe**	**Erzeugen von Einkristallen durch chemische Reaktion von Gasen, z.B. Dampfphasen-Epitaxie mit chemischer Reaktion [3, 2006.01]**
C30B 25/02	1-Punkt Untergruppe	. Epitaktisches Schichtenwachstum [3, 2006.01]
C30B 25/04	2-Punkt Untergruppe	. . Abscheiden von Profilen, z.B. durch Maskieren [3, 2006.01]
C30B 25/06	2-Punkt Untergruppe	. . durch reaktives Sputtering [3, 2006.01]
C30B 25/08	2-Punkt Untergruppe	. . Reaktionskammern; Auswahl der Materialien dafür [3, 2006.01]
C30B 25/10	2-Punkt Untergruppe	. . Erhitzen der Reaktionskammer oder des Substrats [3, 2006.01]
C30B 25/12	2-Punkt Untergruppe	. . Substrathalter oder Substratträger [3, 2006.01]
C30B 25/14	2-Punkt Untergruppe	. . Zu- und Ableitungen für die Gase; Regulierung des Gasstroms [3, 2006.01]
C30B 25/16	2-Punkt Untergruppe	. . Steuern oder Regeln (Steuern oder Regeln allgemein G05) [3, 2006.01]
C30B 25/18	2-Punkt Untergruppe	. . gekennzeichnet durch das Substrat [3, 2006.01]
C30B 25/20	3-Punkt Untergruppe	. . . wobei das Substrat aus denselben Stoffen wie die epitaktische Schicht ist [3, 2006.01]
C30B 25/22	2-Punkt Untergruppe	. . Sandwich-Verfahren [3, 2006.01]
C30B 27/00	**Hauptgruppe**	**Einkristallwachstum unter einem schützenden Fluid [3, 2006.01]**
C30B 27/02	1-Punkt Untergruppe	. durch Ziehen aus einer Schmelze [3, 2006.01]
C30B 28/00	**Hauptgruppe**	**Herstellung von homogenen polykristallinen Stoffen mit definierter Struktur [5, 2006.01]**
C30B 28/02	1-Punkt Untergruppe	. direkt aus dem festen Zustand [5, 2006.01]
C30B 28/04	1-Punkt Untergruppe	. aus Flüssigkeiten [5, 2006.01]
C30B 28/06	2-Punkt Untergruppe	. . durch normales Ausfrieren oder Ausfrieren unter einem Temperaturgradienten [5, 2006.01]
C30B 28/08	2-Punkt Untergruppe	. . durch Zonenschmelzen [5, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
C30B 28/10	2-Punkt Untergruppe	. . durch Ziehen aus einer Schmelze [5, 2006.01]
C30B 28/12	1-Punkt Untergruppe	. direkt aus dem Gaszustand [5, 2006.01]
C30B 28/14	2-Punkt Untergruppe	. . durch chemische Reaktion reaktionsfähiger Gase [5, 2006.01]
C30B 29/00	**Hauptgruppe**	**Einkristalle oder homogene polykristalline Stoffe mit definierter Struktur, gekennzeichnet durch das Material oder durch ihre Form [3, 5, 2006.01]**
C30B 29/02	1-Punkt Untergruppe	. Elemente [3, 2006.01]
C30B 29/04	2-Punkt Untergruppe	. . Diamant [3, 2006.01]
C30B 29/06	2-Punkt Untergruppe	. . Silicium [3, 2006.01]
C30B 29/08	2-Punkt Untergruppe	. . Germanium [3, 2006.01]
C30B 29/10	1-Punkt Untergruppe	. Anorganische Verbindungen oder Zusammensetzungen [3, 2006.01]
C30B 29/12	2-Punkt Untergruppe	. . Halogenide [3, 2006.01]
C30B 29/14	2-Punkt Untergruppe	. . Phosphate [3, 2006.01]
C30B 29/16	2-Punkt Untergruppe	. . Oxide [3, 2006.01]
C30B 29/18	3-Punkt Untergruppe	. . . Quarz [3, 2006.01]
C30B 29/20	3-Punkt Untergruppe	. . . Aluminiumoxide [3, 2006.01]
C30B 29/22	3-Punkt Untergruppe	. . . Zusammengesetzte Oxide [3, 2006.01]
C30B 29/24	4-Punkt Untergruppe	. . . . der Formel $AMeO_3$, wobei A ein Metall der Seltenen Erden ist und Me ist Fe, Ga, Sc, Cr, Co oder Al, z.B. Orthoferrite [3, 2006.01]
C30B 29/26	4-Punkt Untergruppe	. . . . der Formel BMe_2O_4 , wobei B ist Mg, Ni, Co, Al, Zn oder Cd, und Me ist Fe, Ga, Sc, Cr, Co oder Al [3, 2006.01]
C30B 29/28	4-Punkt Untergruppe	. . . . der Formel A_3 Me_5O_{12} , wobei A ein Metall der Seltenen Erden ist und Me ist Fe, Ga, Sc, Cr, Co oder Al, z.B. Granate [3, 2006.01]
C30B 29/30	4-Punkt Untergruppe	. . . . Niobate; Vanadate; Tantalate [3, 2006.01]
C30B 29/32	4-Punkt Untergruppe	. . . . Titanate; Germanate; Molybdate; Wolframate [3, 2006.01]
C30B 29/34	2-Punkt Untergruppe	. . Silicate [3, 2006.01]
C30B 29/36	2-Punkt Untergruppe	. . Carbide [3, 2006.01]
C30B 29/38	2-Punkt Untergruppe	. . Nitride [3, 2006.01]
C30B 29/40	2-Punkt Untergruppe	. . $A_{III}B_V$-Verbindungen [3, 2006.01]
C30B 29/42	3-Punkt Untergruppe	. . . Galliumarsenid [3, 2006.01]
C30B 29/44	3-Punkt Untergruppe	. . . Galliumphosphid [3, 2006.01]
C30B 29/46	2-Punkt Untergruppe	. . Schwefel, Selen oder Tellur enthaltende Verbindungen [3, 2006.01]
C30B 29/48	3-Punkt Untergruppe	. . . $A_{II}B_{VI}$-Verbindungen [3, 2006.01]
C30B 29/50	4-Punkt Untergruppe	. . . . Cadmiumsulfid [3, 2006.01]
C30B 29/52	2-Punkt Untergruppe	. . Legierungen [3, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
C30B 29/54	1-Punkt Untergruppe	. Organische Verbindungen [3, 2006.01]
C30B 29/56	2-Punkt Untergruppe	. . Tartrate [3, 2006.01]
C30B 29/58	2-Punkt Untergruppe	. . Makromolekulare Verbindungen [3, 2006.01]
C30B 29/60	1-Punkt Untergruppe	. gekennzeichnet durch die Form [3, 2006.01]
C30B 29/62	2-Punkt Untergruppe	. . Whisker oder Nadeln [3, 2006.01]
C30B 29/64	2-Punkt Untergruppe	. . Flache Kristalle, z.B. Platten, Bänder oder Scheiben [5, 2006.01]
C30B 29/66	2-Punkt Untergruppe	. . Kristalle komplexer geometrischer Form, z.B. Rohre, Zylinder [5, 2006.01]
C30B 29/68	2-Punkt Untergruppe	. . Kristalle mit Schichtstrukturen, z.B. "Übergitter" ["Superlattices"] [5, 2006.01]
C30B 30/00	**Hauptgruppe**	**Herstellung von Einkristallen oder homogenen polykristallinen Stoffen mit definierter Struktur durch Anwendung von elektrischen oder magnetischen Feldern, Schwingungsenergie oder unter Anwendung sonstiger spezieller physikalischer Bedingungen [5, 2006.01]**
C30B 30/02	1-Punkt Untergruppe	. durch Anwendung elektrischer Felder, z.B. Elektrolyse [5, 2006.01]
C30B 30/04	1-Punkt Untergruppe	. durch Anwendung magnetischer Felder [5, 2006.01]
C30B 30/06	1-Punkt Untergruppe	. durch Anwendung mechanischer Schwingungen [5, 2006.01]
C30B 30/08	1-Punkt Untergruppe	. unter Schwerelosigkeit oder geringer Schwerkraft [5, 2006.01]
		Nachbehandlung von Einkristallen oder homogenen polykristallinen Stoffen mit definierter Struktur [3, 5]
C30B 31/00	**Hauptgruppe**	**Diffusionsverfahren oder Dotierverfahren für Einkristalle oder homogene polykristalline Stoffe mit definierter Struktur; Vorrichtungen dafür [3, 5, 2006.01]**
C30B 31/02	1-Punkt Untergruppe	. durch Inberührungbringen mit Diffusionsstoffen in festem Zustand [3, 2006.01]
C30B 31/04	1-Punkt Untergruppe	. durch Kontaktieren mit Diffusionsstoffen im flüssigen Zustand [3, 2006.01]
C30B 31/06	1-Punkt Untergruppe	. durch Inberührungbringen mit Diffusionsstoffen in gasförmigem Zustand [3, 2006.01]
C30B 31/08	2-Punkt Untergruppe	. . wobei die Diffusionsstoffe Verbindungen der zu diffundierenden Elemente sind [3, 2006.01]
C30B 31/10	2-Punkt Untergruppe	. . Reaktionskammern; Auswahl der Materialien dafür [3, 2006.01]
C30B 31/12	2-Punkt Untergruppe	. . Heizen der Reaktionskammer [3, 2006.01]
C30B 31/14	2-Punkt Untergruppe	. . Substrathalter oder Substratträger [3, 2006.01]
C30B 31/16	2-Punkt Untergruppe	. . Zuleitungen und Ableitungen für die Gase; Regulierung des Gasstroms [3, 2006.01]
C30B 31/18	2-Punkt Untergruppe	. . Steuern oder Regeln [3, 2006.01]
C30B 31/20	1-Punkt Untergruppe	. Dotieren durch Bestrahlen mit elektromagnetischen Wellen oder durch Teilchenstrahlung [3, 2006.01]
C30B 31/22	2-Punkt Untergruppe	. . durch Ionen-Implantation [3, 2006.01]
C30B 33/00	**Hauptgruppe**	**Nachbehandlung von Einkristallen oder homogenen polykristallinen Stoffen mit definierter Struktur (C30B 31/00 hat Vorrang) [3, 5, 2006.01]**
C30B 33/02	1-Punkt Untergruppe	. Wärmebehandlung (C30B 33/04 , C30B 33/06 haben Vorrang) [5, 2006.01]
C30B 33/04	1-Punkt Untergruppe	. durch Anwendung elektrischer oder magnetischer Felder oder von Teilchenstrahlung [5, 2006.01]
C30B 33/06	1-Punkt Untergruppe	. Zusammenfügen von Kristallen [5, 2006.01]
C30B 33/08	1-Punkt Untergruppe	. Ätzen [5, 2006.01]

Symbol	Typ	Titel
C30B 33/10	2-Punkt Untergruppe	. . in Lösungen oder Schmelzen [5, 2006.01]
C30B 33/12	2-Punkt Untergruppe	. . in Gasatmosphäre oder Plasma [5, 2006.01]
C30B 35/00	**Hauptgruppe**	**Vorrichtungen, besonders ausgebildet für Wachstum, Herstellung und Nachbehandlung von Einkristallen oder von homogenen polykristallinen Stoffen mit definierter Struktur, soweit nicht anderweitig vorgesehen [3, 5, 2006.01]**